01,13

Межфазная энергия на границе металлический кристалл-расплав

© Л.П. Арефьева¹, И.Г. Шебзухова²

Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону, Россия ² Кабардино-Балкарский государственный университет, Нальчик, Россия

E-mail: Ludmilochka529@mail.ru, Irina.Shebzukhova@mail.ru

(Поступила в Редакцию 10 января 2018 г. В окончательной редакции 12 февраля 2018 г.)

> Разработана методика оценки межфазной энергии нанокристаллов переходных металлов и ее анизотропии на границе с собственным расплавом. Получено выражение для координаты границы Гиббса с учетом размерной зависимости. Межфазная энергия кристаллических граней на границе с собственным расплавом мономорфных 4*d*- и 5*d*-металлов нелинейно уменьшается при уменьшении размера нанокристалла и при определенном размере исчезает. При радиусе нанокристалла более 10 nm межфазная энергия граней приближается к значениям для макрокристалла. Температурная зависимость межфазной энергии на фазовой границе кристалл-расплав практически линейна. Показано, что разработанная методика находится в согласии с известными экспериментальными данными для моно- и поликристаллов и пригодна для оценки ориентационной, температурной и размерной зависимостей межфазной энергии нано-, микро- и макрокристаллов на границе с собственным расплавом.

DOI: 10.21883/FTT.2018.07.46108.010

1. Введение

Уменьшение свободной энергии, в том числе межфазной энергии (МЭ), системы является движущей силой фазовых переходов, включая процессы кристаллизации и плавления. Межфазная энергия определяется как обратимая работа, необходимая для создания единицы площади межфазной границы между кристаллом и контактирующей с ним жидкой фазой и является фундаментальной характеристикой материалов.

Существует ряд экспериментальных методов, позволяющих измерить МЭ или межфазное натяжение (МН) кристалла на границе с собственным расплавом — в опытах по переохлаждению расплава [1–3], по двугранному углу [4–6] и форме малоугловой границы зерен [7,8], по понижению температуры плавления частиц малых размеров [9], молекулярной динамики [10–13]. Данные, полученные указанными методами, имеют заметный разброс.

Как известно, большинство свойств и параметров кристаллов изменяются при уменьшении размеров. Измерение МЭ с технической точки зрения процедура весьма непростая и трудоемкая. Поэтому до сих пор для переходных металлов данные по МЭ либо вообще отсутствуют, либо сильно расходятся. Однако для моделирования процессов зарождения и роста новой фазы и управления ими знание данной зависимости необходимо.

Также на протяжении нескольких десятилетий развивались теоретические методы оценки МЭ или МН макрокристаллов и малых частиц, которые условно можно разделить на следующие группы: термодинамические [14–19], структурно-термодинамические [20,21], молекулярно-статистические [3] и электронно-статистические [22-28]. Термодинамические методы позволяют выразить МЭ металлических моно- и поликристаллов через температуры и теплоты фазовых превращений [14-18], а также позволяют учесть вклад автоадсорбции в величину МЭ поликристалла [19]. В работах Магомедова [17,18] проведен последовательный анализ зависимостей скрытой теплоты, скачков объема и МЭ при фазовом переходе кристалл-жидкость от размера и формы кристаллов. Показано, что для любого однокомпонентного вещества МЭ кристалла должна исчезать при определенном размере наночастицы. При данном размере скрытая теплота фазового перехода кристалл-жидкость становится равной нулю и исчезает различие фаз. Форма нанокристаллов в общем случае может быть произвольной, но наиболее равновесной из возможных изоморфных форм (пластинчатой, стержневидной и кубической) является кубическая [17].

В работах [22,23] для расчета ориентационной зависимости МЭ простых металлов на границе с собственным расплавом был развит электронно-статистический метод, который в дальнейшем распространили на случай переходных металлов с учетом зависимости МЭ от температуры [24,25] и размеров кристалла [26].

В обзоре [28] проанализированы экспериментальные данные о форме металлических частиц с размерами менее 100 nm. Малые металлические частицы могут иметь форму сферы или многогранника. Возможно также сосуществование граней и скругленных участков поверхности. При росте температуры происходит уменьшение площади граней, т.е. термическое загрубление поверхности.

В настоящей работе ставилась цель в рамках электронно-статистического метода описать размерную зави-

симость МЭ граней кристаллов мономорфных 4*d*- и 5*d*-металлов на границе с собственным расплавом.

2. Координата границы Гиббса и электронная плотность металлического нанокристалла

Рассмотрим металлический кристалл малого размера, покрытый слоем расплава. Будем считать, что контактирующие фазы находятся в термодинамическом равновесии. Поведение коллективизированных электронов переходных металлов вблизи межфазной границы с расплавом описывается с помощью изотропной модели металла. Физическую R и гиббсову R_{Γ} поверхности раздела кристалл-расплав выбираем также, как в работах [22–28].

Электронная плотность и потенциал вблизи границы раздела металлический нанокристалл-расплав находим из уравнения Томаса-Ферми аналогично работам [22,24,26]. Уравнения Томаса-Ферми для малого металлического кристалла, окруженного слоем собственного расплава макроскопической толщины, выраженные через безразмерные координату $\varepsilon = r/s$ и потенциал $\chi(\varepsilon) = V(r)/V_R$ записываются в виде

$$arepsilon\chi''(arepsilon) + 2\chi'(arepsilon) = arepsilon \left| \chi^{3/3}(arepsilon) - 1 \right|$$
 при $0 \le arepsilon \le arepsilon_R$, (1)
 $arepsilon\chi''(arepsilon) + 2\chi'(arepsilon) = arepsilon \left[\chi^{3/2}(arepsilon) - rac{1}{1+p}
ight]$

при $\varepsilon_R \leq \varepsilon \leq +\infty$. (2)

Здесь *s* — коэффициент, выражающийся через потенциал Ферми металла (параметр, приводящий уравнение Томаса-Ферми к безразмерному виду), *p* относительное изменение плотности металла при фазовом переходе, $V_R = (5/3)(k_k/e)\rho^{2/3}(0)$ — потенциал Ферми в центре кристалла, $e = 4.8 \cdot 10^{-10}$ СГСЭ, $k_k = (3/\pi)^{2/3}(3h^2/40m)$, *m* — масса электрона, *h* постоянная Планка.

Граничные условия для уравнений (1) и (2): $\chi(\varepsilon) = 1$ и $\chi'(\varepsilon) = 0$ при $\varepsilon = 0$, $\chi(\varepsilon) = (1 - p)^{2/3}$ и $\chi'(\varepsilon) = 0$ при $\varepsilon = +\infty$, а на физической поверхности раздела нанокристалл-расплав ($\varepsilon = \varepsilon_R$) функции $\chi(\varepsilon)$ и $\chi'(\varepsilon)$ являются непрерывными.

Выражения для электронной плотности и потенциала с учетом внутренней области нанокристалла и внешней среды можно записать

$$\rho(r) = \rho(0) \left[\chi_i^{3/2}(\varepsilon) \cdot \theta(\varepsilon_R - \varepsilon) + \chi_e^{3/2}(\varepsilon) \cdot \theta(\varepsilon_R + \varepsilon) \right],$$
(3)
$$V(r) = V_R \left[\chi_i(\varepsilon) \cdot \theta(\varepsilon_R - \varepsilon) + \chi_e(\varepsilon) \cdot \theta(\varepsilon_R + \varepsilon) \right],$$
(4)

где $\theta(\varepsilon_R \pm \varepsilon)$ — ступенчатая функция Хэвисайда, $\rho(0)$ — электронная плотность металла в центре нанокристалла.

Электронную плотность и потенциал нанокристалла можно выразить через электронную плотность

$$ho(\infty) = z/\Omega$$
 и потенциал V_i полубесконечного кристалла

$$\rho(r) = \rho(0)\chi^{3/2}(\varepsilon) = \lambda \rho(\infty)\chi^{3/2}(\varepsilon), \qquad (5)$$

$$V(r) = V_R \chi(\varepsilon) = \lambda^{2/3} V_i \chi(\varepsilon), \qquad (6)$$

где *z* — число свободных электронов на атом, Ω — объем ячейки Вигнера-Зейтца-Свэттера.

Решениями уравнений (1) и (2) для внутренней и внешней частей системы с учетом граничных условий являются функции

$$\chi_i(\varepsilon) = 1 - \frac{1 - \chi_p(\varepsilon_R)}{\left(1 - (\varepsilon - \varepsilon_R)/c\right)^6} \quad \text{при} \quad 0 \le \varepsilon \le \varepsilon_R, \quad (7)$$
 $\chi_e(\varepsilon) = \frac{1}{(1+p)^{2/3}} + \frac{A}{\left(1 + (\varepsilon - \varepsilon_R)/c\right)^n}$

при $\varepsilon_R \leq \varepsilon \leq +\infty$. (8)

Здесь $\chi_p(\varepsilon_R)$, *c*, *A* и *n* найдены из условий непрерывности $\chi(\varepsilon)$ и $\chi'(\varepsilon)$ на межфазной границе и из предельного перехода (8) к функции $\chi_e(\varepsilon)$ для случая наночастица—вакуум

$$\chi_p(\varepsilon_R) = \frac{3}{5} \cdot \frac{1+p}{p} \left[1 - \frac{1}{(1+p)^{5/3}} \right], \quad c = 2.1 \cdot (125/3)^{1/4}$$
(9)
$$A = \chi_p(\varepsilon_R) - (1+p)^{-2/3}, \quad n = 6 \cdot \frac{1-\chi_p(\varepsilon_R)}{A}, \quad (10)$$

Значение безразмерного коэффициента λ найдено из закона сохранения электронного заряда зерна нанокристалла

$$\lambda = \frac{p\varepsilon_R^3 (1-\delta)^3}{3\left\{\int_0^{\varepsilon_R} \left[\chi_i^{3/2}(\varepsilon) - (1+p)^{-1}\right]\varepsilon^2 d\varepsilon + \int_{\varepsilon_R}^{\infty} \left[\chi_e^{3/2}(\varepsilon) - (1+p)^{-1}\right]\varepsilon^2 d\varepsilon\right\}},$$
(11)

где $\delta \cong \varepsilon_R^{-1}$ — коэффициент разрыхления. При разложении подынтегральных выражений в (11) в степенные ряды можно ограничиться первыми двумя членами ряда, так как модули вторых слагаемых в выражениях (7) и (8) много меньше единицы. После преобразований получим выражение для безразмерного коэффициента λ , учитывающее зависимость величин от изменения плотности фаз на границе раздела и линейного размера нанокристалла. С увеличением размера нанокристалла значение λ возрастает по полиномиальному закону и стремится к единице. Следовательно, при $\varepsilon_R \to \infty$ происходит предельный переход от нанокристалла к макрокристаллу, что позволяет использовать выражения (7) и (8) при описании свойств нано-, микро- и макроразмерных систем.

График электронной плотности металла $\rho(r)$ и ее зависимость от размера кристалла показаны на рис, 1 на примере иридия. Как видно из рис. 1, при уменьшении размера кристалла уровень электронной плотности иридия нелинейно снижается по сравнению с макрокристаллом. Ход электронной плотности становится более пологим. Данные закономерности справедливы для всех рассматриваемых в работе металлов.



Рис. 1. Зависимость электронной плотности иридия от размера кристалла: *I* — 2 nm; *2* — 5 nm; *3* — 10 nm; *4* — 100 nm; *5* — макрокристалл.



Рис. 2. Зависимость координаты гиббсовой поверхности раздела на границе металлический кристалл—расплав от размера кристалла.

Межфазная энергия грани $f_{\omega 12}^{(T)}(hkl)$ определяется относительно гиббсовой поверхности раздела нанокристалл металла—собственный расплав. Координата гиббсовой поверхности раздела ε_{Γ} для системы нанокристалл металла—расплав находится из условия электронейтральности на границе контакта фаз

$$\varepsilon_{\Gamma} = \varepsilon_{R} - \frac{3}{2} \frac{Ac(1+p)^{2/3}}{p(n-1)} - \frac{3c(1-\chi_{p}(0))(1+p)}{10p} \left(1 - \left(1 + \frac{\varepsilon_{R}}{c}\right)^{-5}\right).$$
(12)

На рис. 2 представлена зависимость координаты гиббсовой поверхности раздела частица-расплав в ви-

де $\varepsilon_{\Gamma} - \varepsilon_{R}$ от размера частицы для пяти переходных металлов.

Координата границы Гиббса $\varepsilon_{\Gamma} > \varepsilon_{R}$, что объясняется вытягиванием "хвоста" электронной плотности во внешнюю область системы. Как видно из графиков (рис. 2), при увеличении размера частицы величина $\varepsilon_{\Gamma} - \varepsilon_{R}$ для всех металлов уменьшается и примерно при 100 nm становится равной координате границы Гиббса макрокристалла, т.е. гиббсова поверхность раздела при увеличении геометрических размеров кристалла сдвигается в сторону физической поверхности раздела.

Межфазная энергия металлического нанокристалла на границе с собственным расплавом

Используя термодинамическое определение Гиббса для МЭ металла на границе с расплавом, и учитывая температурный вклад, МЭ граней представим в виде

$$f_{\omega 12}^{(T)}(hkl) = f_{\omega 12}^{(i0)}(hkl) + f_{\omega 12}^{(e0)}(hkl) + \Delta f_{\omega 12}^{(iT)}(hkl) + \Delta f_{\omega 12}^{(eT)}(hkl).$$
(13)

Здесь $f_{\omega 12}^{(i0)}$ и $f_{\omega 12}^{(e0)}(hkl)$ — внутренний и внешний вклады в МЭ граней нанокристалла при 0 К, $\Delta f_{\omega 12}^{(iT)}(hkl)$ и $\Delta f_{\omega 12}^{(eT)}(hkl)$ — внутренний и внешний температурные вклады в МЭ граней.

При расчете МЭ нанокристаллов *d*-металлов на границе с собственным расплавом учитывались вклады электрон-электронного, электрон-ионного и ион-ионного взаимодействий в энергию решетки кристалла и соответствующие плотности энергий для расплава. Отдельные слагающие энергии элементарного шара, входящие в $f_{\omega 12}^{(i0)}(hkl)$ и $f_{\omega 12}^{(e0)}(hkl)$, вычислялись по формулам из работы [30].

На рис. З показана размерная зависимость внутреннего вклада в МЭ кристаллов переходных металлов на примере граней (110) и (111) молибдена, вольфрама, иридия и платины. Как видно, с уменьшением размера кристаллов внутренний вклад в МЭ граней убывает нелинейно. При размера кристалла порядка 10–12 nm величина внутреннего вклада приближается к значениям для макрокристалла и ее рост значительно замедляется. Данные закономерности справедливы и для других мономорфных 4*d*- и 5*d*-металлов.

Межфазная энергия граней кристаллов рассчитывалась для трех температур — 0 К, 293 К, температуре плавления макрокристалла. Температурный вклад в МЭ нанокристаллов и тонких пленок рассматривался нами ранее в работе [26].

Температурный вклад в МЭ внутренней области нанокристалла состоит из слагаемого, обусловленного



Рис. 3. Размерная зависимость внутреннего вклада в МЭ граней нанокристаллов *d*-металлов на границе с собственным расплавом.

ионной компонентой металла

$$\Delta f_{\omega 12}^{(Tu)}(hkl) = \left(1 - \chi_p(0)\right)$$

$$\times \left(-\frac{9}{4}k_BTn(hkl) - 9s\left(\frac{k_BR^*\theta\alpha_l T}{\hbar}\right)^2 D^*\right) \sum_{k=0} \Psi^{-6},$$
(14)

и слагаемого, обусловленного размытием уровня Ферми металла

$$\Delta f_{\omega 12}^{(Te)} = -\frac{\pi^2 k_B^2 c_S T^2}{4eV_R} \rho(0) \\ \times \left(\frac{A}{2(1+p)^{1/3}(n-1)} - \frac{1-\chi_p(0)}{10} - \Phi \frac{p}{1+p}\right).$$
(15)

Здесь $\Psi = (1 - (\varepsilon)_k - \varepsilon_R)/c), \Phi = (\varepsilon_{\Gamma} - \varepsilon_R)/c, k_B$ — постоянная Больмана, θ — температура Дебая, α_l — температурный коэффициент линейного расширения, R^* — радиус *s*-сферы, \hbar — постоянная Планка, $D^* = D(1 - \delta), D$ — плотность кристалла.

Формула (14) учитывает ориентационную зависимость температурного вклада в МЭ металлических нанокристаллов.

Температурный вклад в МЭ для внешней области системы получен в виде

$$\Delta f_{\omega 12}^{(eT)} = \frac{9}{4} csk_B n_{ev} T \frac{A(1+p)^{-2/3}}{(1+\Phi)^{n-1}} \\ \times \left[\frac{1}{n-1} - \frac{1}{2n-1} \frac{A(1+p)^{-2/3}}{(1+\Phi)^n} \right], \quad (16)$$

где *n_{ev}* — число частиц в единице объема расплава.

Размерная зависимость температурного вклада в МЭ граней рассчитана по формулам (14)–(16). Температурный вклад в МЭ граней отрицателен, по величине составляет десятки mJ/m^2 для разных граней при температурах плавления макрокристаллов. При увеличении размера нанокристалла температурный вклад в МЭ граней по величине возрастает (рис. 4).

Для расчета поляризации поверхностных ионов на межфазной границе металлический нанокристалл-расплав мы преобразовали формулу из [31] для границы металл-вакуум. Деформационную энергию поляризации ионов в *k*-слое грани в расчете на элементарный шар можно определить как

$$f_{\omega}^{(p)} = -\frac{18\alpha\lambda^3 V_R^2}{\xi^2 s^2} \frac{[1 - \chi_{pR}(0)]^2}{c^2} n(hkl) \sum_k \Psi^{-14}, \quad (17)$$

где α — поляризуемость ионов, n(hkl) — концентрация частиц на грани (hkl), ξ — коэффициент, учитывающий обменное взаимодействие, k — номер атомного слоя.

Деформационная энергия поляризации ионов отрицательна, по абсолютной величине мала ($\sim 10^{-4}\,mJ/m^2)$ и имеет значительную анизотропию. Размерную зависимость поляризационной поправки можно также как и



Рис. 4. Размерная зависимость температурного вклада в МЭ граней кристаллов вольфрама и молибдена на границе с собственным расплавом.



Рис. 5. Размерная зависимость дисперсионного вклада в МЭ граней нанокристалла.



Рис. 6. Размерная зависимость осцилляционного вклада в МЭ нанокристалла.



Рис. 7. Размерная зависимость внешнего вклада в МЭ граней нанокристаллов *d*-металлов на границе с собственным расплавом.

зависимость внутреннего вклада, выразить полиномом шестого порядка.

Также оценены осцилляционная $f_{\omega 12}^{oc}$ и дисперсионная $f_{\omega 12}^{g}(hkl)$ поправки к внутреннему вкладу МЭ. На рис. 5 и 6 показаны зависимости $f_{\omega 12}^{oc}$ и $f_{\omega 12}^{g}(hkl)$ на границе металлический нанокристалл—собственный расплав от радиуса кристалла. Осцилляционная и дисперсионная поправки к МЭ рассматриваемых металлов положительны, вносят вклад в величину $f_{\omega 12}^{(i0)}(hkl)$ менее 1% и от 0.5 до 6% соответственно. Величина $f_{\omega 12}^{g}(hkl)$ является нелинейной убывающей функцией размера кристалла. Осцилляционная кристалла.

Нами получено выражение для вклада в МЭ внешней части распределения электронного газа с учетом скачка плотности при фазовом переходе кристалл—расплав и линейных размеров нанокристалла. Как видно из рис. 7, величина внешнего вклада отрицательна и для ОЦК-металлов по модулю в два—три раза выше, чем для ГЦК-металлов. Размерная зависимость $f_{\omega 12}^{(e0)}(hkl)$ для обеих кристаллических структур выражается полиномиальной функцией шестой степени, но для металлов с ОЦК-структурой она значительнее.

Мы рассчитали МЭ граней для кристаллов палладия, платины, иридия, родия, ниобия, молибдена, тантала и вольфрама на границе с собственными расплавами. Полученные результаты представлены на рис. 8 на примере МЭ грани (110).

Как видно из графиков (рис. 8), МЭ граней на границе с собственным расплавом металла нелинейно увеличивается по мере роста размера кристалла. Размерная зависимость МЭ нанокристаллов (рис. 8) по характеру аналогична размерной зависимости МЭ ориентированных тонких пленок переходных металлов на границе с вакуумом, рассчитанной данным методом [25]. Но величина МЭ граней нано- и макрокристаллов на границе с собственным расплавом значительно ниже (более, чем на 45%) поверхностной энергии тонких пленок и макрокристаллов на границе с вакуумом [25].

Размерную зависимость МЭ граней можно в общем виде представить как полином шестой степени с достоверностью аппроксимации, равной единице,

$$f_{\omega 12}(\overline{R}) = -a\overline{R}^6 + b\overline{R}^5 - c\overline{R}^4 + d\overline{R}^3 - g\overline{R}^2 + h\overline{R} - j,$$
(18)

где a, b, c, d, g, h, j — положительные действительные числа, \overline{R} — усредненный по граням размер нанокристалла.

Приравнивая (18) к нулю и решая получившееся уравнение относительно \overline{R} , получаем значение размера \overline{R} наночастицы от 0.2 до 0.5 nm для рассматриваемых в работе металлов. Следовательно, развитый нами метод расчета размерной зависимости МЭ удовлетворяет физически обоснованному требованию $f_{\omega 12}^{(T)}(hkl) = 0$ при исчезновении различия фаз [17].



Рис. 8. Межфазная энергия 4*d*- и 5*d*-металлов на границе с собственным расплавом при 293 К: (*a*) *1* — Pt, *2* — Ir, *3* — Rh, *4* — Pd. (*b*) *1* — W, *2* — Mo, *3* — Ta, *4* — Nb.

К сожалению, в литературе крайне мало данных по МЭ и МН металлических частиц. Холломон и Тарнбалл [3] методом кристаллизации переохлажденного расплава платины получили значение МЭ 240 mJ/m². В работе [32] приведено значение МЭ платины 323 mJ/m², полученное по измерению двугранного угла малоуговой границы. Усредненное по граням значение МЭ нанокристаллов размером 1 nm, полученное нами, находятся в удовлетворительном согласии с данными [3,32].

Из сравнения расчетных значений МЭ с экспериментальными данными по ПЭ поликристаллов видно, что при размере нанокристалла 1 nm МЭ составляет порядка 20–26% от ПЭ для 4*d*- и 5*d*-металлов, а при $\overline{R} = 10$ nm от 41 до 48% от ПЭ, что согласуется с теоретическими оценками других авторов.

В работе [32] по формулам разных авторов были рассчитаны МН и МЭ 62 металлов с учетом температурной и размерной зависимости. Наши результаты по МЭ граней систематически завышены, относительно приведенных в [32].

4. Заключение

Электронно-статистический метод расчета МЭ металлических кристаллов распространен на случай межфазной границы нанокристалл металла—собственный расплав. При увеличении размера кристалла происходит предельный переход от нанокристалла к макрокристаллу, что позволяет использовать выражения для потенциала и электронной плотности для описания свойств нано-, микро- и макроразмерных объектов. Полученные результаты согласуются с термодинамическими представлениями и адекватно описывают изменение величины МЭ граней нанокристаллов переходных металлов на границе с жидкой металлической фазой.

Список литературы

- [1] D. Turnbull, R.E. Cech. J. Appl. Phys. 21, 804 (1950).
- [2] D. Turnbull. J. Appl. Phys. 21, 1022 (1950).
- [3] Н. Холломон, Л. Тарнбалл. УФН 1, 304 (1956).
- [4] M.E. Glicksman, C. Vold. Acta Metal. 17, 1 (1969).
- [5] L. Felberbaum, A. Rossoll, A. Mortensen. J. Mater. Sci. 40, 3121 (2005).
- [6] M. Erol, K. Keşlioğlu, N. Maraşli. Metallurg. Mater. Transactions A 38, 1539 (2007).
- [7] K. Keşlioğlu, N. Maraşh. Mater. Sci. Eng. A 369, 294 (2004).
- [8] Y. Kaygısız, S. Akbulut, Y. Ocak, K. Keşlioğlu, N. Maraşlı, E. Çadırlı, H. Kaya. J. Alloys Comp. 487, 103 (2009).
- [9] D.R.H. Jones. J. Mater. Sci. 9, 1 (1974).
- [10] V.I. Mazhukin, A.V. Shapranov, V.E. Perezhigin, O.N. Koroleva, A.V. Mazhukin. Mathemat. Models Comp. Simulat. 9, 448 (2017).
- [11] S.R. Wilson, M.I. Mendelev. J. Chem. Phys. 144, 144707 (2016).
- [12] J.J. Hoyt, M. Asta, A. Karma. Phys. Rev. Lett. 86, 5530 (2001).
- [13] Д.Н. Соколов, Н.Ю. Сдобняков, П.В. Комаров. В сб.: Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов / Под ред. В.М. Самсонова, Н.Ю. Сдобнякова. Тверской гос. ун-т, Тверь (2011) 3, 284 с.
- [14] Л.М. Щербаков. В сб.: Поверхностные явления в расплавах и процессах порошковой металлургии / Под. ред. С.Н. Задумкина. Из-во АН УССР, Киев (1963). С. 38.
- [15] Т.М. Таова, М.Х. Хоконов. В сб.: Физика межфазных явлений / Под ред. Х.Б. Хоконова. КБГУ, Нальчик (1984). С. 88.
- [16] Т.М. Таова, М.Х. Хоконов. В сб. тр. I Междунар. симпозиума "Плавление и кристаллизация металлов и оксидов". ИПО ПИ ЮФУ, Ростов н/Д. (2007). С. 164.
- [17] М.Н. Магомедов. ФТТ 46, 924 (2004).
- [18] М.Н. Магомедов. ЖТФ 84, 46 (2014).
- [19] В.М. Яковлев, А.И. Крестелев. Письма в ЖТФ 24, 5, 81 (1998).
- [20] A.S. Skapski. Acta Metallurgica 4, 576 (1956).
- [21] С.Н. Задумкин. Изв. АН СССР. ОТН. Металлургия и топливо 1, 55 (1961).
- [22] С.Н. Задумкин. ФММ 13, 1. 24 (1962).

- [23] С.Н. Задумкин, В.К. Кумыков, И.Г. Шебзухова. В сб.: тр. межвуз. науч. конф. по физике межфазных явлений и избранным вопросам математики, посвященной 50-летию образования СССР / Под ред. С.Н. Задумкина. КБГУ, Нальчик (1972). 3, с. 10.
- [24] И.Г. Шебзухова, Л.П. Арефьева, Х.Б. Хоконов. В сб.: Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов / Под ред. В.М. Самсонова, Н.Ю. Сдобнякова. Тверской гос. ун-т, Тверь (2012). 4, с. 319.
- [25] Л.П. Арефьева, Т.Г. Шебзухова. В сб.: Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов / Под ред. В.М. Самсонова, Н.Ю. Сдобнякова. Тверской гос. ун-т, Тверь (2016). 8, с. 26.
- [26] Л.П. Арефьева, И.Г. Шебзухова. В сб.: Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов / Под ред. В.М. Самсонова, Н.Ю. Сдобнякова. Тверской гос. ун-т, Тверь (2013). 5, с. 20.
- [27] Х.Б. Хоконов, С.Н. Задумкин. В сб.: Поверхностные явления в расплавах и возникающих из них твердых фазах / Под ред. С.Н. Задумкина. Кабардино-Балкарское книжн. изд-во, Нальчик (1965). С. 75.
- [28] С.Н. Задумкин. ФММ 11, 3, 331 (1961).
- [29] Э.Л. Нагаев. УФН 162, 9, 49 (1992).
- [30] П. Гамбош. Статистическая теория атома и ее применение. ИЛ, М. (1951). 337 с.
- [31] С.Н. Задумкин, И.Г. Шебзухова, Р.М. Дигилов. В сб.: Физическая химия поверхностных явлений в расплавах / Под ред. С.Н. Задумкина. Наук. думка, Киев (1971). С. 32.
- [32] H.M. Lu. Solid State Phenomena 155, 3 (2009).

Редактор Т.Н. Василевская